

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年4月5日(2012.4.5)

【公開番号】特開2010-258252(P2010-258252A)

【公開日】平成22年11月11日(2010.11.11)

【年通号数】公開・登録公報2010-045

【出願番号】特願2009-107347(P2009-107347)

【国際特許分類】

H 01 L 29/78 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 5 2 K

H 01 L 29/78 6 5 3 A

H 01 L 29/78 6 5 2 M

H 01 L 29/78 6 5 8 G

H 01 L 29/78 6 5 2 D

H 01 L 29/78 6 5 8 F

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月20日(2012.2.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に形成されたエピタキシャル層に第1のトレンチと当該第1のトレンチを更に深くエッチングすることで第2のトレンチを形成し、

前記第2のトレンチの幅を拡張し、

前記拡張された第2のトレンチを酸化することで酸化膜を形成し、

前記第1のトレンチ及び前記酸化膜が形成された第2のトレンチに電極材料を充填する、

半導体装置の製造方法。